

Symbol	Typ	Titel
C	Sektion	Sektion C – Chemie; Hüttenwesen
C30	Klasse	Züchten von Kristallen [3]
C30B	Unterkategorie	Züchten von Einkristallen (durch Anwendung von Ultra-Hochdruck, z.B. zur Erzeugung von Diamanten, B01J 3/06); Gerichtetes Erstarren von eutektischen Stoffen oder gerichtetes Entmischen von eutektischen Stoffen; Reinigen von Stoffen durch Zonenschmelzen (Reinigen von Metallen oder Legierungen durch Zonenschmelzen C22B); Herstellung eines homogenen polykristallinen Stoffes mit definierter Struktur (Gießen von Metallen, Gießen anderer Werkstoffe nach dem gleichen Verfahren oder mit den gleichen Vorrichtungen B22D; Verarbeiten von Kunststoffen B29; Veränderung der physikalischen Struktur von Metallen oder Legierungen C21D , C22F); Einkristalle oder homogene polykristalline Stoffe mit definierter Struktur; Nachbehandlung von Einkristallen oder eines homogenen polykristallinen Stoffes mit definierter Struktur (zur Herstellung von Halbleiterbauelementen oder ihren Teilen H10); Apparate hierfür [3]
		<u>Einkristallwachstum aus festen Stoffen oder Gelen [3]</u>
C30B 1/00	Hauptgruppe	Einkristallwachstum direkt aus dem festen Zustand (gerichtetes Entmischen von eutektischen Stoffen C30B 3/00; unter einem schützenden Fluid C30B 27/00) [3, 2006.01]
C30B 1/02	1-Punkt Untergruppe	. durch Wärmebehandlung, z.B. Ausglühen von Gitterspannungen (C30B 1/12 hat Vorrang) [3, 2006.01]
C30B 1/04	2-Punkt Untergruppe	... Isotherme Rekristallisation [3, 2006.01]
C30B 1/06	2-Punkt Untergruppe	... Rekristallisation unter einem Temperaturgradienten [3, 2006.01]
C30B 1/08	3-Punkt Untergruppe	... Zonenrekristallisation [3, 2006.01]
C30B 1/10	1-Punkt Untergruppe	. durch Feststoffreaktion oder Mehrphasen-Diffusion [3, 2006.01]
C30B 1/12	1-Punkt Untergruppe	. durch Druckbehandlung während des Wachstums [3, 2006.01]
C30B 3/00	Hauptgruppe	Gerichtetes Entmischen von eutektischen Stoffen [3, 2006.01]
C30B 5/00	Hauptgruppe	Einkristallwachstum aus Gelen (unter einem schützenden Fluid C30B 27/00) [3, 2006.01]
C30B 5/02	1-Punkt Untergruppe	. unter Zugabe von Dotierstoffen [3, 2006.01]
		<u>Einkristallwachstum aus Flüssigkeiten; gerichtetes Erstarren von eutektischen Stoffen [3]</u>
C30B 7/00	Hauptgruppe	Einkristallwachstum aus Lösungen unter Verwendung von Lösungsmitteln, die bei normaler Temperatur flüssig sind, z.B. wässrige Lösungen (aus geschmolzenen Lösungsmitteln C30B 9/00; durch Kühlen mit oder ohne Temperaturgradient C30B 11/00; unter einem schützenden Fluid C30B 27/00) [3, 2006.01]
C30B 7/02	1-Punkt Untergruppe	. durch Verdampfung des Lösungsmittels [3, 2006.01]
C30B 7/04	2-Punkt Untergruppe	... unter Verwendung von wässrigen Lösungsmitteln [3, 2006.01]
C30B 7/06	2-Punkt Untergruppe	... unter Verwendung von nichtwässrigen Lösungsmitteln [3, 2006.01]
C30B 7/08	1-Punkt Untergruppe	. durch Abkühlen der Lösung [3, 2006.01]
C30B 7/10	1-Punkt Untergruppe	. durch Anwendung von Druck, z.B. hydrothermale Verfahren [3, 2006.01]
C30B 7/12	1-Punkt Untergruppe	. durch Elektrolyse [3, 2006.01]
C30B 7/14	1-Punkt Untergruppe	. die auskristallisierenden Stoffe werden durch chemische Reaktionen in der Lösung gebildet [3, 2006.01]
C30B 9/00	Hauptgruppe	Einkristallwachstum aus Lösungsschmelzen unter Verwendung von geschmolzenen Lösungsmitteln (durch Kühlen mit oder ohne Temperaturgradient C30B 11/00; durch Zonenschmelzen C30B 13/00; Kristallziehen C30B 15/00; auf einem eingetauchten Keimkristall C30B 17/00; durch Flüssigphasen-Epitaxie C30B 19/00; unter einem schützenden Fluid C30B 27/00) [3, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
C30B 9/02	1-Punkt Untergruppe	. durch Verdampfen des geschmolzenen Lösungsmittels [3, 2006.01]
C30B 9/04	1-Punkt Untergruppe	. durch Kühlen der Lösung [3, 2006.01]
C30B 9/06	2-Punkt Untergruppe	... unter Verwendung von einer Komponente der Kristallverbindung als Lösungsmittel [3, 2006.01]
C30B 9/08	2-Punkt Untergruppe	... unter Verwendung von anderen Lösungsmitteln [3, 2006.01]
C30B 9/10	3-Punkt Untergruppe	... metallische Lösungsmittel [3, 2006.01]
C30B 9/12	3-Punkt Untergruppe	... Salze als Lösungsmittel, z.B. Wachstum aus Schmelzen mit Flussmitteln [3, 2006.01]
C30B 9/14	1-Punkt Untergruppe	. durch Elektrolyse [3, 2006.01]
C30B 11/00	Hauptgruppe	Erzeugen von Einkristallen durch Kühlen mit oder ohne Temperaturgradient, z.B. Bridgman-Stockbarger-Methode (C30B 13/00 , C30B 15/00 , C30B 17/00 , C30B 19/00 haben Vorrang; unter einem schützenden Fluid C30B 27/00) [3, 2006.01]
C30B 11/02	1-Punkt Untergruppe	. ohne Lösungsmittel (C30B 11/06 hat Vorrang) [3, 2006.01]
C30B 11/04	1-Punkt Untergruppe	. Einbringen der zu kristallisierenden Stoffe oder der den Stoff <u>in situ</u> bildenden Komponenten in die Schmelze [3, 2006.01]
C30B 11/06	2-Punkt Untergruppe	... wobei wenigstens eine, aber nicht alle Komponenten der Kristallverbindung zugegeben werden [3, 2006.01]
C30B 11/08	2-Punkt Untergruppe	... wobei alle Komponenten der Kristallverbindung während der Kristallisation zugegeben werden [3, 2006.01]
C30B 11/10	3-Punkt Untergruppe	... feste oder flüssige Komponenten, z.B. Verneuil-Methode [3, 2006.01]
C30B 11/12	3-Punkt Untergruppe	... dampfförmige Komponenten, z.B. VLS- [vapour-liquid-solid] Verfahren [3, 2006.01]
C30B 11/14	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch den Keimkristall, z.B. seine kristallografische Orientierung [3, 2006.01]
C30B 13/00	Hauptgruppe	Erzeugen von Einkristallen durch Zonenschmelzen; Reinigen durch Zonenschmelzen (C30B 17/00 hat Vorrang; durch Ändern des Querschnitts des behandelten festen Stoffes C30B 15/00; unter einem schützenden Fluid C30B 27/00; für das Wachstum von homogenen polykristallinen Stoffen mit definierter Struktur C30B 28/00) [3, 5, 2006.01]
C30B 13/02	1-Punkt Untergruppe	. Zonenschmelzen mit einem Lösungsmittel, z.B. travelling-solvent-Methode [Verwendung einer wandernden Schmelzlösungsmittelzone] [3, 2006.01]
C30B 13/04	1-Punkt Untergruppe	. Homogenisieren durch "zone-levelling" [3, 2006.01]
C30B 13/06	1-Punkt Untergruppe	. die Schmelzone nimmt nicht den ganzen Querschnitt ein [3, 2006.01]
C30B 13/08	1-Punkt Untergruppe	. Einbringen der zu kristallisierenden Stoffe oder der den Stoff <i>in situ</i> bildenden Komponenten in die Schmelzone [3, 2006.01]
C30B 13/10	2-Punkt Untergruppe	... unter Zusetzen von Dotierstoffen [3, 2006.01]
C30B 13/12	3-Punkt Untergruppe	... in gasförmigem oder dampfförmigem Zustand [3, 2006.01]
C30B 13/14	1-Punkt Untergruppe	. Tiegel oder Gefäße [3, 2006.01]
C30B 13/16	1-Punkt Untergruppe	. Erhitzen der Schmelzone [3, 2006.01]
C30B 13/18	2-Punkt Untergruppe	... wobei das Heizelement in Kontakt mit der Schmelzone steht oder in sie eingetaucht ist [3, 2006.01]
C30B 13/20	2-Punkt Untergruppe	... durch Induktion, z.B. Heißdraht-Technik (C30B 13/18 hat Vorrang) [3, 2006.01]
C30B 13/22	2-Punkt Untergruppe	... durch Bestrahlung oder elektrische Entladung [3, 2006.01]
C30B 13/24	3-Punkt Untergruppe	... mit elektromagnetischen Wellen [3, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
C30B 13/26	1-Punkt Untergruppe	. unter Röhren der Schmelzzone [3, 2006.01]
C30B 13/28	1-Punkt Untergruppe	. Steuern oder Regeln [3, 2006.01]
C30B 13/30	2-Punkt Untergruppe	.. Stabilisation oder Formgebung der Schmelzzone, z.B. durch Verdichten, durch elektromagnetische Felder; Steuern des Kristallquerschnitts [3, 2006.01]
C30B 13/32	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen, um entweder die Charge oder das Heizelement zu bewegen [3, 2006.01]
C30B 13/34	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch den Keim, z.B. durch seine kristallografische Orientierung [3, 2006.01]
C30B 15/00	Hauptgruppe	Erzeugen von Einkristallen durch Ziehen aus einer Schmelze, z.B. Czochralsky-Verfahren (unter einem schützenden Fluid C30B 27/00) [3, 2006.01]
C30B 15/02	1-Punkt Untergruppe	. Einbringen der zu kristallisierenden Stoffe oder der den Stoff in situ bildenden Komponenten in die Schmelze [3, 2006.01]
C30B 15/04	2-Punkt Untergruppe	.. unter Zusetzen von Dotierstoffen, z.B. für n-p-Übergang [3, 2006.01]
C30B 15/06	1-Punkt Untergruppe	. Nicht-senkreiches Ziehen [3, 2006.01]
C30B 15/08	1-Punkt Untergruppe	. Abwärtsziehen [3, 2006.01]
C30B 15/10	1-Punkt Untergruppe	. Tiegel oder Behälter für die Schmelze [3, 2006.01]
C30B 15/12	2-Punkt Untergruppe	.. Doppeltiegel-Verfahren [3, 2006.01]
C30B 15/14	1-Punkt Untergruppe	. Erhitzen der Schmelze oder der kristallisierten Stoffe [3, 2006.01]
C30B 15/16	2-Punkt Untergruppe	.. durch Bestrahlung oder elektrische Entladung [3, 2006.01]
C30B 15/18	2-Punkt Untergruppe	.. mit direkter Widerstandsheizung zusätzlich zu anderen Erhitzungsverfahren, z.B. mit Peltier- Wärme [3, 2006.01]
C30B 15/20	1-Punkt Untergruppe	. Steuern oder Regeln (Steuern oder Regeln allgemein G05) [3, 2006.01]
C30B 15/22	2-Punkt Untergruppe	.. Stabilisierung oder Formgebung der Schmelzzone nahe dem gezogenen Kristall; Steuern des Kristallquerschnitts [3, 2006.01]
C30B 15/24	3-Punkt Untergruppe	... unter Verwendung von mechanischen Mitteln, z.B. Formwerkzeugen (formgebende Elemente für kantenbestimmtes, schmelzfilmbeschicktes Kristallwachstum C30B 15/34) [3, 2006.01]
C30B 15/26	3-Punkt Untergruppe	... unter Verwendung von Fernsehkameras; unter Verwendung von Foto- oder Röntgen-Detektoren [3, 2006.01]
C30B 15/28	3-Punkt Untergruppe	... unter Ausnutzung von Gewichtsveränderungen des Kristalls oder der Schmelze, z.B. Flotationsverfahren [Schwimm-Tiegel-Verfahren] [3, 2006.01]
C30B 15/30	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Rotieren oder Bewegen der Schmelze oder des Kristalls (Schwimm-Verfahren C30B 15/28) [3, 2006.01]
C30B 15/32	1-Punkt Untergruppe	. Keimhalter, z.B. Spannfutter [3, 2006.01]
C30B 15/34	1-Punkt Untergruppe	. kantenbestimmendes, schmelzfilmbeschicktes Ziehen von Kristallen mit formgebenden Elementen oder Schlitten [3, 2006.01]
C30B 15/36	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch den Keim, z.B. durch seine kristallografische Orientierung [3, 2006.01]
C30B 17/00	Hauptgruppe	Einkristallwachstum auf einem Keim, der während des Wachstums in der Schmelze verbleibt, z.B. Nacken-Kyropoulos-Verfahren (C30B 15/00 hat Vorrang) [3, 2006.01]
C30B 19/00	Hauptgruppe	Flüssigphasen-Epitaxie [LPE-Verfahren] [3, 2006.01]
C30B 19/02	1-Punkt Untergruppe	. mit geschmolzenen Lösungsmitteln, z.B. Flussmitteln [3, 2006.01]
C30B 19/04	2-Punkt Untergruppe	.. wobei das Lösungsmittel eine Komponente der Kristallverbindung ist [3, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
C30B 19/06	1-Punkt Untergruppe	. Reaktionskammern; Gefäße für die Schmelze; Substraträger [3, 2006.01]
C30B 19/08	1-Punkt Untergruppe	. Erhitzen der Reaktionskammern oder des Substrates [3, 2006.01]
C30B 19/10	1-Punkt Untergruppe	. Steuern oder Regeln (Steuern oder Regeln allgemein G05) [3, 2006.01]
C30B 19/12	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch das Substrat [3, 2006.01]
C30B 21/00	Hauptgruppe	Gerichtetes Erstarren von eutektischen Stoffen [3, 2006.01]
C30B 21/02	1-Punkt Untergruppe	. durch einfaches Gießen oder Kühlen mit Temperaturgradient [3, 2006.01]
C30B 21/04	1-Punkt Untergruppe	. durch Zonenschmelzen [3, 2006.01]
C30B 21/06	1-Punkt Untergruppe	. durch Ziehen aus einer Schmelze [3, 2006.01]
		Einkristallwachstum aus der Dampfphase [3]
C30B 23/00	Hauptgruppe	Erzeugen von Einkristallen durch Niederschlagen von verdampften oder sublimierten Stoffen [3, 2006.01]
C30B 23/02	1-Punkt Untergruppe	. Epitaktisches Schichtenwachstum [3, 2006.01]
C30B 23/04	2-Punkt Untergruppe	.. Abscheiden von Profilen, z.B. durch Maskieren [3, 2006.01]
C30B 23/06	2-Punkt Untergruppe	.. Erhitzen der Abscheidekammer, des Substrats oder der zu verdampfenden Stoffe [3, 2006.01]
C30B 23/08	2-Punkt Untergruppe	.. durch Niederschlagen von ionisierten Dämpfen (durch reaktives Sputtering C30B 25/06) [3, 2006.01]
C30B 25/00	Hauptgruppe	Erzeugen von Einkristallen durch chemische Reaktion von Gasen, z.B. Dampfphasen-Epitaxie mit chemischer Reaktion [3, 2006.01]
C30B 25/02	1-Punkt Untergruppe	. Epitaktisches Schichtenwachstum [3, 2006.01]
C30B 25/04	2-Punkt Untergruppe	.. Abscheiden von Profilen, z.B. durch Maskieren [3, 2006.01]
C30B 25/06	2-Punkt Untergruppe	.. durch reaktives Sputtering [3, 2006.01]
C30B 25/08	2-Punkt Untergruppe	.. Reaktionskammern; Auswahl der Materialien dafür [3, 2006.01]
C30B 25/10	2-Punkt Untergruppe	.. Erhitzen der Reaktionskammer oder des Substrats [3, 2006.01]
C30B 25/12	2-Punkt Untergruppe	.. Substrathalter oder Substraträger [3, 2006.01]
C30B 25/14	2-Punkt Untergruppe	.. Zu- und Ableitungen für die Gase; Regulierung des Gasstroms [3, 2006.01]
C30B 25/16	2-Punkt Untergruppe	.. Steuern oder Regeln (Steuern oder Regeln allgemein G05) [3, 2006.01]
C30B 25/18	2-Punkt Untergruppe	.. gekennzeichnet durch das Substrat [3, 2006.01]
C30B 25/20	3-Punkt Untergruppe	... wobei das Substrat aus denselben Stoffen wie die epitaktische Schicht ist [3, 2006.01]
C30B 25/22	2-Punkt Untergruppe	.. Sandwich-Verfahren [3, 2006.01]
C30B 27/00	Hauptgruppe	Einkristallwachstum unter einem schützenden Fluid [3, 2006.01]
C30B 27/02	1-Punkt Untergruppe	. durch Ziehen aus einer Schmelze [3, 2006.01]
C30B 28/00	Hauptgruppe	Herstellung von homogenen polykristallinen Stoffen mit definierter Struktur [5, 2006.01]
C30B 28/02	1-Punkt Untergruppe	. direkt aus dem festen Zustand [5, 2006.01]
C30B 28/04	1-Punkt Untergruppe	. aus Flüssigkeiten [5, 2006.01]
C30B 28/06	2-Punkt Untergruppe	.. durch normales Ausfrieren oder Ausfrieren unter einem Temperaturgradienten [5, 2006.01]
C30B 28/08	2-Punkt Untergruppe	.. durch Zonenschmelzen [5, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
C30B 28/10	2-Punkt Untergruppe	... durch Ziehen aus einer Schmelze [5, 2006.01]
C30B 28/12	1-Punkt Untergruppe	. direkt aus dem Gaszustand [5, 2006.01]
C30B 28/14	2-Punkt Untergruppe	... durch chemische Reaktion reaktionsfähiger Gase [5, 2006.01]
C30B 29/00	Hauptgruppe	Einkristalle oder homogene polykristalline Stoffe mit definierter Struktur, gekennzeichnet durch das Material oder durch ihre Form [3, 5, 2006.01]
C30B 29/02	1-Punkt Untergruppe	. Elemente [3, 2006.01]
C30B 29/04	2-Punkt Untergruppe	... Diamant [3, 2006.01]
C30B 29/06	2-Punkt Untergruppe	... Silicium [3, 2006.01]
C30B 29/08	2-Punkt Untergruppe	... Germanium [3, 2006.01]
C30B 29/10	1-Punkt Untergruppe	. Anorganische Verbindungen oder Zusammensetzungen [3, 2006.01]
C30B 29/12	2-Punkt Untergruppe	... Halogenide [3, 2006.01]
C30B 29/14	2-Punkt Untergruppe	... Phosphate [3, 2006.01]
C30B 29/16	2-Punkt Untergruppe	... Oxide [3, 2006.01]
C30B 29/18	3-Punkt Untergruppe	... Quarz [3, 2006.01]
C30B 29/20	3-Punkt Untergruppe	... Aluminiumoxide [3, 2006.01]
C30B 29/22	3-Punkt Untergruppe	... Zusammengesetzte Oxide [3, 2006.01]
C30B 29/24	4-Punkt Untergruppe der Formel AMe_3 , wobei A ein Metall der Seltenen Erden ist und Me ist Fe, Ga, Sc, Cr, Co oder Al, z.B. Orthoferrite [3, 2006.01]
C30B 29/26	4-Punkt Untergruppe der Formel BMe_2O_4 , wobei B ist Mg, Ni, Co, Al, Zn oder Cd, und Me ist Fe, Ga, Sc, Cr, Co oder Al [3, 2006.01]
C30B 29/28	4-Punkt Untergruppe der Formel $A_3Me_5O_{12}$, wobei A ein Metall der Seltenen Erden ist und Me ist Fe, Ga, Sc, Cr, Co oder Al, z.B. Granate [3, 2006.01]
C30B 29/30	4-Punkt Untergruppe Niobate; Vanadate; Tantalate [3, 2006.01]
C30B 29/32	4-Punkt Untergruppe Titanate; Germanate; Molybdate; Wolframate [3, 2006.01]
C30B 29/34	2-Punkt Untergruppe	... Silicate [3, 2006.01]
C30B 29/36	2-Punkt Untergruppe	... Carbide [3, 2006.01]
C30B 29/38	2-Punkt Untergruppe	... Nitride [3, 2006.01]
C30B 29/40	2-Punkt Untergruppe	... $A_{III}B_V$ -Verbindungen [3, 2006.01]
C30B 29/42	3-Punkt Untergruppe	... Galliumarsenid [3, 2006.01]
C30B 29/44	3-Punkt Untergruppe	... Galliumphosphid [3, 2006.01]
C30B 29/46	2-Punkt Untergruppe	... Schwefel, Selen oder Tellur enthaltende Verbindungen [3, 2006.01]
C30B 29/48	3-Punkt Untergruppe	... $A_{II}B_{VI}$ -Verbindungen [3, 2006.01]
C30B 29/50	4-Punkt Untergruppe Cadmiumsulfid [3, 2006.01]
C30B 29/52	2-Punkt Untergruppe	... Legierungen [3, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
C30B 29/54	1-Punkt Untergruppe	. Organische Verbindungen [3, 2006.01]
C30B 29/56	2-Punkt Untergruppe	... Tartrate [3, 2006.01]
C30B 29/58	2-Punkt Untergruppe	... Makromolekulare Verbindungen [3, 2006.01]
C30B 29/60	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch die Form [3, 2006.01]
C30B 29/62	2-Punkt Untergruppe	... Whisker oder Nadeln [3, 2006.01]
C30B 29/64	2-Punkt Untergruppe	... Flache Kristalle, z.B. Platten, Bänder oder Scheiben [5, 2006.01]
C30B 29/66	2-Punkt Untergruppe	... Kristalle komplexer geometrischer Form, z.B. Rohre, Zylinder [5, 2006.01]
C30B 29/68	2-Punkt Untergruppe	... Kristalle mit Schichtstrukturen, z.B. "Übergitter" ["Superlattices"] [5, 2006.01]
C30B 30/00	Hauptgruppe	Herstellung von Einkristallen oder homogenen polykristallinen Stoffen mit definierter Struktur durch Anwendung von elektrischen oder magnetischen Feldern, Schwingungsenergie oder unter Anwendung sonstiger spezieller physikalischer Bedingungen [5, 2006.01]
C30B 30/02	1-Punkt Untergruppe	. durch Anwendung elektrischer Felder, z.B. Elektrolyse [5, 2006.01]
C30B 30/04	1-Punkt Untergruppe	. durch Anwendung magnetischer Felder [5, 2006.01]
C30B 30/06	1-Punkt Untergruppe	. durch Anwendung mechanischer Schwingungen [5, 2006.01]
C30B 30/08	1-Punkt Untergruppe	. unter Schwerelosigkeit oder geringer Schwerkraft [5, 2006.01]
		<u>Nachbehandlung von Einkristallen oder homogenen polykristallinen Stoffen mit definierter Struktur [3, 5]</u>
C30B 31/00	Hauptgruppe	Diffusionsverfahren oder Dotierverfahren für Einkristalle oder homogene polykristalline Stoffe mit definierter Struktur; Vorrichtungen dafür [3, 5, 2006.01]
C30B 31/02	1-Punkt Untergruppe	. durch Inberührungbringen mit Diffusionsstoffen in festem Zustand [3, 2006.01]
C30B 31/04	1-Punkt Untergruppe	. durch Kontaktieren mit Diffusionsstoffen im flüssigen Zustand [3, 2006.01]
C30B 31/06	1-Punkt Untergruppe	. durch Inberührungbringen mit Diffusionsstoffen in gasförmigem Zustand [3, 2006.01]
C30B 31/08	2-Punkt Untergruppe	... wobei die Diffusionsstoffe Verbindungen der zu diffundierenden Elemente sind [3, 2006.01]
C30B 31/10	2-Punkt Untergruppe	... Reaktionskammern; Auswahl der Materialien dafür [3, 2006.01]
C30B 31/12	2-Punkt Untergruppe	... Heizen der Reaktionskammer [3, 2006.01]
C30B 31/14	2-Punkt Untergruppe	... Substrathalter oder Substratträger [3, 2006.01]
C30B 31/16	2-Punkt Untergruppe	... Zuleitungen und Ableitungen für die Gase; Regulierung des Gasstroms [3, 2006.01]
C30B 31/18	2-Punkt Untergruppe	... Steuern oder Regeln [3, 2006.01]
C30B 31/20	1-Punkt Untergruppe	. Dotieren durch Bestrahlen mit elektromagnetischen Wellen oder durch Teilchenstrahlung [3, 2006.01]
C30B 31/22	2-Punkt Untergruppe	... durch Ionen-Implantation [3, 2006.01]
C30B 33/00	Hauptgruppe	Nachbehandlung von Einkristallen oder homogenen polykristallinen Stoffen mit definierter Struktur (C30B 31/00 hat Vorrang) [3, 5, 2006.01]
C30B 33/02	1-Punkt Untergruppe	. Wärmebehandlung (C30B 33/04, C30B 33/06 haben Vorrang) [5, 2006.01]
C30B 33/04	1-Punkt Untergruppe	. durch Anwendung elektrischer oder magnetischer Felder oder von Teilchenstrahlung [5, 2006.01]
C30B 33/06	1-Punkt Untergruppe	. Zusammenfügen von Kristallen [5, 2006.01]
C30B 33/08	1-Punkt Untergruppe	. Ätzen [5, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
C30B 33/10	2-Punkt Untergruppe	. . . in Lösungen oder Schmelzen [5, 2006.01]
C30B 33/12	2-Punkt Untergruppe	. . . in Gasatmosphäre oder Plasma [5, 2006.01]
C30B 35/00	Hauptgruppe	Vorrichtungen, besonders ausgebildet für Wachstum, Herstellung und Nachbehandlung von Einkristallen oder von homogenen polykristallinen Stoffen mit definierter Struktur, soweit nicht anderweitig vorgesehen [3, 5, 2006.01]